



دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر

تکلیف کامپیوتری ۱ درس الکترونیک ۲

شبیه سازی تقویت کننده سورس مشترک و درین مشترک

استاد درس:

دكتر ناصر معصومي

دستيار آموزشي:

علی قاسم پور

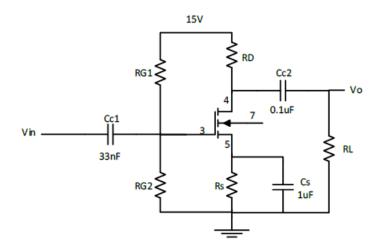
در این تمرین با کمک نرم افزار PSPICE، با یکی از کاربرد های ترانزیستور MOS به عنوان تقویت کنندگی و تاثیر پارامتر های مختلف بر نقطه کار مدار و بهره ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی آشنا می شوید.

۱-تقویت کننده سورس مشترک

 R_S شکل ۱ مدار یک تقویت کننده سورس مشترک را نشان میدهد که از بایاسینگ ثابت با مقاومت سورس R_S به منظور پایدارسازی بایاس نسبت به حرارت و تغیرات مشخصه ترانزیستورها استفاده شده است. در این نوع بایاسینگ بیشتر در مدارهای ترانزیستوری گسسته مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که برای مدارهای یکپارچه از منابع جریان و مقاومتهای فیدبک استفاده می شود. این نوع تقویت کننده ها به دلیل مقاومت ورودی زیاد و بهره ولتاژ بالا معمولا در طبقات ورودی به کار می روند.

اگر ترانزیستور در ناحیه اشباع باشد جریان ترانزیستور از رابطه زیر بدست میآید:

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{I} (V_{GS} - V_t)^2$$
 and $V_{DS} > (V_{GS} - V_t)$



شکل 1 تقویت کننده سورس مشترک

 $R_{in}>15K\Omega$ و $V_{T0}\approx1.4V$ ، $K'\frac{W}{L}=0.7~mA/V^2$ ، $I_D=0.6v$ ، $V_S\approx3V$ و الف) اگر الف) اگر الف) اگر وسط $V_S=0.6v$ باشد، مقادیر $V_S=0.7~mA/V^2$ ، $V_S=0.6v$ ، V_S

ب-۱) مقدار مقاومت R_L را R_L قرار داده و مدار را در نرمافزار PSPIC شبیه سازی کنید. نقاط کار حاصل از شبیه سازی مدار با مقادیر تئوری تفاوتی دارد؟ R_L تفاوتی وجود دارد دلیل آن چیست؟

ب-۲)توان مصرفی حاصل از شبیه سازی مدار را بدست آورید و گزارش دهید.

ب-۳) مدار را در دمای ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درجه شبیه سازی کنید و نقاط کاری آن را گزارش دهید.

ج) هدایت انتقالی (سیگنال کوچک) از رابطه زیر بدست میآید:

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial V_{GS}}\Big|_Q = k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) = \sqrt{2I_D k_n' \frac{W}{L}} \qquad or \qquad g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t}$$

و همچنین بهره مدار با فرض $R_D || R_L > r_0 > r_0$ برابر است با:

$$A_{v} = -g_{m}(R_{D}||R_{L}||r_{o}) \approx -g_{m}(R_{D}||R_{L})$$

ج-۱) با توجه به مطالب گفته شده بهره ولتاژ خروجی در گره V_o به ولتاژ ورودی در گره V_i را به صورت تئوری بدست آورید.

۱۰ mV و دامنه ۱۰ KHz و رمحیط شبیه سازی به ورودی مدار در گره V_i ولتاژ سینوسی با فرکانس ۱۰ KHz و دامنه V_o اعمال کنید و شکل موج ولتاژ خروجی در گره V_o را مشاهده و گزارش دهید. بهره ولتاژ خروجی در گره V_o به ولتاژ ورودی در گره V_i حاصل از شبیه سازی را گزارش دهید. دلیل تفاوت با مقدار تئوری چیست. مقاومت بار و از مقدار V_i مقدار V_i و بهره ولتاژ خروجی در گره V_o و بهره ولتاژ خروجی در گره V_o به ولتاژ ورودی در گره V_i را مشاهده و گزارش دهید.

راهنمایی: برای بدست آوردن و یا رسم بهره ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی میتوانید در محیط نرم افزار از ماشین حساب آن استفاده کرده و شکل موج ولتاژ خروجی را به ولتاژ ورودی تقسیم کنید و یا از تحلیل AC استفاده کنید.

ج-۳) با سری کردن مقاومت R_{Sig} با R_{Sig} به مقدار ۵ $K\Omega$ در محیط شبیه سازی، شکل موج ولتاژ خروجی در گره V_i را مشاهده و گزارش دهید و اثر آن در بهره ولتاژ خروجی در گره V_o به ولتاژ ورودی در گره V_i را گزارش دهید.

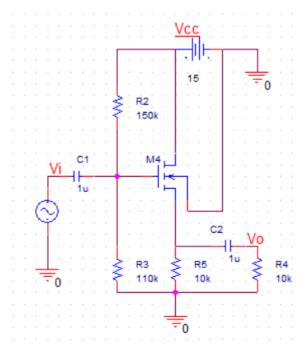
ج-۴) دامنه ولتاژ ورودی در گره V_i را در محیط شبیه سازی افزایش داده و حداکثر سویینگ ولتاژ خروجی در گره گره V_i با حداکثر سویینگ ولتاژ خروجی در گره گره V_i با حداکثر سویینگ ولتاژ خروجی در گره V_i را مشاهده و گزارش دهید.

ج-۵) با جاروب فرکانس ولتاژ ورودی در گره V_i از ۱۰ Hz تا ۱۰ MHz در محیط شبیه سازی، فرکانس قطع یایین مدار را مشاهده و گزارش دهید.

* در این تقویت کننده در نرم افزار PSPICE از کتابخانه CD4007 استفاده کنید.

۲-تقویت کننده درین مشترک

شکل ۲ مدار یک تقویت کننده درین مشترک را نشان میدهد. این نوع تقویت کننده ها به دلیل مقاومت خروجی کم، مقاومت ورودی زیاد و بهره ولتاژ نزدیک به یک معمولا در طبقات خروجی به کار میروند.



شکل ۲ تقویت کننده درین مشترک

الف) مدار را در نرمافزار PSPIC شبیه سازی کنید. نقاط کار حاصل از شبیه سازی مدار را گزارش دهید.

۱۰ mV و دامنه ۱۰ KHz با در محیط شبیه سازی به ورودی مدار در گره V_i ولتاژ سینوسی با فرکانس ۱۰ KHz و دامنه V_o به اعمال کنید و شکل موج ولتاژ خروجی در گره V_o را مشاهده و گزارش دهید. بهره ولتاژ خروجی در گره V_o به ولتاژ ورودی در گره V_i حاصل از شبیه سازی را گزارش دهید.

ج) با جاروب فرکانس ولتاژ ورودی در گره V_i از V_i تا ۱۰ MHz در محیط شبیه سازی، فرکانس قطع پایین مدار را مشاهده و گزارش دهید. با تغییر خازن C_2 به مقدار μm کفرکانس قطع مدار را مشاهده و گزارش دهید.

nmos و ترانزیستور BREAK از کتابخانه PSPICE و ترانزیستور V استفاده کنید. $V_{TO}=2V$, $V_{TO}=1.1 \frac{mA}{V^2}$, $V_{TO}=1.1 \frac{mA}{V^2}$, $V_{TO}=1.1 \frac{mA}{V^2}$

* در این تمرین کامپیوتری، انجام تمرین تقویت کننده سورس مشترک الزامی و تمرین تقویت کننده درین مشترک میباشد و همچنین فاقد مشترک اختیاری و برای آشنایی بیشتر دانشجویان با مدار تقویت کننده درین مشترک میباشد.

*فایل کتابخانه CD4007 همراه با تمرین در سامانه بارگذاری شده است.

* تمامی نمودارها و نتایج شبیه سازی باید تحلیل شوند. ذکرروابط پارامترها همراه با توضیح الزامی است.

*صفحه اول گزارش باید شامل نام تمرین، نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی باشد. همچنین نمودارها باید شامل زیرنویس، شماره تصویر و توضیحات باشند.

*نمودارها باید پس زمینه سفید داشته باشند.

*فایلهای شبیهسازی را در یک پوشه مجزا قرار داده و همراه با گزارش با فرمت pdf، در یک فایل zip کرده و با فرمت زیر نام گذاری کنید:

ELEC2_CA1_Name_StudentNumber

*تمیزی گزارشکار بخشی از نمره تمرین کامپیوتری را شامل میشود.

در صورت وجود هرگونه مشکل یا سوال در مورد کار با نرم افزار PSPICE، با ایمیل زیر در تماس باشید:

alighasempour086@gmail.com